كتالوج المنتجات

مضخمات قدرة LDMOS

تستخدم مضخمات قدرة LDMOS ترانزستورات MOS ذات انتشار جانبي لرفع قدرة RF. وتحدد المطابقة والانحياز وقمم الإشارة والمسار الحراري الكامل حدود التشغيل.



المنتجات: 2

المراجعة: 2 · تاريخ المراجعة: 2026-11-11



LCPAM-20-520-200A

وحدة مضخم قدرة RF من نوع LDMOS بتردد 20–520 MHz وخرج مشبع 200 W

تستخدم الوحدة مرحلة نهائية LDMOS وتغطي 20–520 MHz بقدرة مشبعة نموذجية 200 W. تحدد القدرة عند انضغاط 1 dB بشكل منفصل عند 50 W نموذجياً، والكسب للإشارة الصغيرة عند 53 dB نموذجياً.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 20; الحد الأقصى: 520; الوحدة: MHz

قدرة خرج RF المشبعة: الرمز: Psat; القيمة النموذجية: 200; الوحدة: W

قدرة الخرج عند انضغاط 1 dB: الرمز: P1dB; القيمة النموذجية: 50; الوحدة: W

كسب الإشارة الصغيرة: الرمز: G; القيمة النموذجية: 53; الوحدة: dB

25 °C; 50 Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAM-20-520-350

مضخم قدرة LDMOS RF 20–520 MHz، خرج مشبع نموذجي 350 W

يغطي مضخم LDMOS نطاق 20–520 MHz بخرج مشبع نموذجي 350 W وخرج نموذجي 150 W عند انضغاط 1 dB. الكسب النموذجي 56 dB، والتيار النموذجي 29 A عند 350 W وتغذية نموذجية 48 VDC.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 20; الحد الأقصى: 520; الوحدة: MHz

قدرة الخرج عند انضغاط 1 dB: الرمز: P-1dB; القيمة النموذجية: 150; الوحدة: W

قدرة خرج PSAT @ RF: الرمز: PSAT; القيمة النموذجية: 350; الوحدة: W

كسب القدرة @ PSAT: الرمز: Gp; القيمة النموذجية: 56; الوحدة: dB

+48.0VDC; 25°C; 50Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.